

特定領域研究 「窒化物光半導体のフロンティア –材料潜在能力の極限発現–」

平成 21 年度 研究会

日時：7月11日（土） 13：15～17：10

場所：立命館大学 びわこ・くさつキャンパス エポック立命 21 3階 K309 会議室

13:15～13:45 挨拶・領域概要説明 名西 徳之

13:45～14:10

A01 東京大学 尾鍋 研太郎

「有機 N 原料による InN および関連混晶薄膜の MOVPE 成長」

14:10～14:35

A02 北海道大学 橋詰 保

「窒化物半導体混晶のバルク準位評価とナノ構造表面制御」

14:35～15:00

A02 東北大学 米永 一郎

「ナイトライド半導体結晶中の転位の運動特性と電子・光学物性の解明」

15:00～15:15 休憩

15:15～15:40

A02 山口大学 山田 陽一

「深紫外混晶半導体における高密度励起子系の光物性評価と光機能性」

15:40～16:05

A02 金沢工業大学 山口 敦史

「窒化物半導体の電子状態・光学特性の理論解析とデバイス構造提案」

16:05～16:30

A03 立命館大学 武内 道一

「2 光束成長その場観察技法を用いた縦型深紫外発光素子の高出力化に関する研究」

16:30～16:55

A04 大阪大学 朝日 一

「InGaN ベース強磁性半導体による長波長円偏光半導体レーザー創製に関する研究」

16:55～17:10 総評・事務連絡